

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2015年1月号

● 特集

p.65 左↑17行目の計算式:

$$I_L = \frac{(V_{in} - V_{out})t_{off}}{L} + I_{max} \rightarrow$$

$$I_L = -\frac{(V_{in} - V_{out})t_{off}}{L} + I_{max}$$

p.69 左↑1行目:ピーク電流2.6A→ピーク電流26A

p.77 コラム 図Dキャプション:電圧が低いと効率は良好であるが精度は悪い→ R_s の端子間電圧が低いと効率は良好であるが精度は悪い

p.84 表1(c)電圧降下の計算式:(20 A)²→20 A

p.85 図5:吹き出し削除

p.112 図2(b): $D_1 \rightarrow D_2$

p.125 左↓12行目:100 kHz→65 kHz

p.125 左↑7行目:入力電圧範囲→入力電流範囲

p.126 表2:順電圧アドミタンス→順伝達アドミタンス

p.126 表2ドレイン-ソース飽和電圧の

測定条件: $V_{GS} \rightarrow V_{GD}$

p.126 表2:順電達アドミタンスの測定条件, $V_{GS} \rightarrow V_{DS}$

p.126 図5:パルス幅1 ms→パルス幅1 S

p.127 図8(a)(b):電流設定電圧 $V_{IFB} \rightarrow$ 電流検出電圧 V_{IFB}

p.128 左↓13行目: μ PC844C→ μ PC844G2

p.128 左↑1行目: $Tr_4 \rightarrow Tr_3$

p.129 図10:1 A/ μ s→2.5 A/ μ s

p.129 図10(a)(b):電流設定電圧 $V_{IFB} \rightarrow$ 電流検出電圧 V_{IFB}

p.129 写真2:抵抗器→熱抵抗

p.130 右↓17行目: $Tr_{12} \rightarrow Tr_{13}$

p.130 右↓19行目: $Tr_{12} \rightarrow Tr_{13}$

p.134 図17キャプション:パワーMOSFETのドレイン-ソース→パワーMOSFETのドレイン-ゲート

p.134 図18: $f_{osc} = 50$ MHz→ $f_{osc} = 50$ kHz

p.134 図18キャプション:ドレイン-ソース間→ドレイン-ゲート間

p.134 右↓4行目:ドレイン-ソース間→ドレイン-ゲート間

p.134 右↓9行目:ドレイン-ソース間→ドレイン-ゲート間

p.135 図20:10 μ s/div→10 ms/div

p.137 図25:1 ms/div→100 ms/div

● ΔS /PCM対応USBレコーダ実験ボードの製作

p.190 図1:高精度なクロック→ホストと同期しないクロック

p.190 左↓12行目:バッファ量が調節→転送量の調節を依頼

p.190 右↓3行目:音飛びなく再生されます→一定速度でデータを送れます

p.191 右↓1行目:少なくなったときは、多めに送ることが許されます→増えたときは、多めに送ります

p.192 コラム 左↑1行目:合わせないとノイズをだします→合せて送るようです

p.196 左↓13行目:DoP対応のUSB DACに→DoP対応のUSB DACのデイスクリプトに